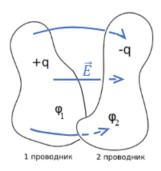
Электрическая емкость систем проводников. Конденсаторы

Поле неуединённого проводника вызывает перераспределение зарядов на окружающих телах – появление индуцированных зарядов

В случае систем, состоящих из двух проводников, вводится понятие взаимной емкости. Перенесем заряд q с одного проводника на другой. При этом второй проводник приобретет заряд q, а первый — заряд -q. Суммарный же заряд системы остается равным 0. При этом разность потенциалов между проводниками $\varphi_2 - \varphi_1 = U$, называемая *напряжением*, будет пропорциональна заряду q: $U \sim q$. Величину

$$C = \frac{q}{U}$$

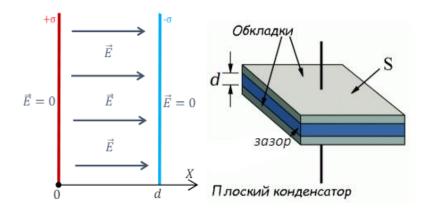
называют взаимной электроёмкостью двух проводников. Взаимная емкость проводников зависит от их формы, размеров, взаимного расположения и наличия диэлектриков.



Конденсаторы - системы проводников, на электрическое поле которых внешние тела практически не оказывают никакого влияния

Обкладки конденсатора имеют заряды противоположного знака (+q и – q). Напряжение между обкладками конденсатора: $U = \varphi + - \varphi - .$

Ёмкость плоского конденсатора



$$E = egin{cases} rac{\sigma}{arepsilon_0} = rac{1}{arepsilon_0} rac{q}{S},$$
 между пластинами 0 , вне пластин

$$U = \varphi(\vec{r}_1) - \varphi(\vec{r}_2) = \int_{\vec{r}_1}^{\vec{r}_2} \vec{E} \cdot d\vec{r} = \int_0^d E \cdot dx = E \cdot \int_0^d dx = E \cdot d.$$

В случае однородных электростатических полей: $U = E \cdot d$.

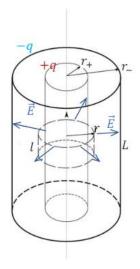
$$U = E \cdot d = \frac{q}{\varepsilon_0 S} \cdot d, \qquad C = \frac{q}{U} = \frac{q \cdot \varepsilon_0 S}{q \cdot d} \implies C = \frac{\varepsilon_0 S}{d}.$$

Если расстояние d очень мало - можно пренебречь краевыми эффектами (нарушением однородности поля вблизи краёв обкладок конденсатора)

Ёмкость цилиндрического конденсатора

состоит из цилиндрических обкладок с единой осью симметрии длиной L и радиусами: r+-у меньшей, r--у большей, ширина зазора $d=r--r+\ll r+$, r-, L.

- 1. в качестве вспомогательной поверхности S возьмём цилиндр с радиусом r и высотой l, такими, что r+< r < r- и $l \ll L$.
- 2. поток ΦS через наш вспомогательный цилиндр равен:



$$\begin{split} \Phi_S &= \oint\limits_{\text{цилиндр}} \vec{E} \, d\vec{S} = \int\limits_{T_1} \vec{E} \, d\vec{S} + \int\limits_{T_2} \vec{E} \, d\vec{S} + \int\limits_{\text{боковая}} \vec{E} \, d\vec{S} = \cdots = \\ &= \int\limits_{\text{боковая}} E \cdot dS_{\text{бок}} = E \int\limits_{\text{боковая}} dS_{\text{бок}} = E \cdot S_{\text{бок}} = E \cdot 2\pi r l. \end{split}$$

3. заряд внутри цилиндра:

$$q^{\text{внутр}} = +\sigma \cdot S = +\sigma \cdot 2\pi r_{+} l = \frac{q}{2\pi r_{+} L} \cdot 2\pi r_{+} l = q \cdot \frac{l}{L}$$

$$E \cdot 2\pi r l = \frac{q}{\varepsilon_0} \cdot \frac{l}{L} \implies E = \frac{q}{2\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{1}{rL}.$$

$$U = \varphi(r_+) - \varphi(r_-) = \int_{r_+}^{r_-} \vec{E} \cdot d\vec{r} = \int_{r_+}^{r_-} E \cdot dr = \int_{r_+}^{r_-} \frac{q}{2\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{1}{rL} \cdot dr = \frac{q}{2\pi\varepsilon_0 L} \int_{r_+}^{r_-} \frac{dr}{r} =$$

$$= \frac{q}{2\pi\varepsilon_0 L} (\ln r_- - \ln r_+) = \frac{q}{2\pi\varepsilon_0 L} \ln \frac{r_-}{r_+}.$$

Электроёмкость цилиндрического конденсатора равна

$$C = \frac{q}{U} = \frac{q \cdot 2\pi\varepsilon_0 L}{q \cdot \ln \frac{r_-}{r_+}} \quad \Longrightarrow \quad C = \frac{2\pi\varepsilon_0 L}{\ln \frac{r_-}{r_+}}.$$

4.

5. Если d мал =>
$$C = \frac{\varepsilon_0 S}{d}.$$

Ёмкость сферического конденсатора

Сферический конденсатор представляет собой две проводящие концентрические сферы радиусами r+ и r-, зазор между которыми равен d=r--r+, $d\ll r-$, r+.

1. вспомогательная замкнутая поверхность S – сфера, её радиус r: r+ < r < r-,

$$\Phi_S = \oint\limits_{\mathrm{c} \Phi \mathrm{epa}} \vec{E} \, d\vec{S} = \dots = E \cdot S_{\mathrm{c} \Phi} = E \cdot 4\pi r^2.$$



3. q внутр = +q, внутрь вспомогательной сферы попал весь заряд внутренней обкладки конденсатора

$$E \cdot 4\pi r^2 = \frac{q}{\varepsilon_0} \implies E = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}.$$

$$U = \varphi(r_+) - \varphi(r_-) = \int_{r_+}^{r_-} \vec{E} \cdot d\vec{r} = \int_{r_+}^{r_-} E \cdot dr = \int_{r_+}^{r_-} \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \cdot dr = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0} \int_{r_+}^{r_-} \frac{dr}{r^2} =$$

$$= \frac{q}{4\pi\varepsilon_0} \cdot (-1) \left(\frac{1}{r_-} - \frac{1}{r_+}\right) = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{r_- - r_+}{r_+ \cdot r_-}.$$

$$C = \frac{q}{U} = 4\pi\varepsilon_0 \frac{r_+ \cdot r_-}{r_- - r_+}.$$

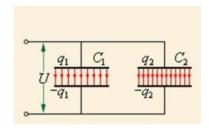
4.

параллельное соединение двух конденсаторов

Напряжение между обкладками обоих конденсаторов одинаковы, а заряды обкладок складываются: q = q1 + q2

$$\frac{q}{U} = \frac{q_1 + q_2}{U} = \frac{q_1}{U} + \frac{q_2}{U}.$$
 $C = C_1 + C_2.$

последовательное соединение двух конденсаторов



Заряды равны и противоположны по знаку.

Таким образом заряды обоих конденсаторов одинаковы. Напряжения при последовательном соединении складываются:

$$U = U_1 + U_2.$$

A поскольку $U = \frac{q}{c}$, получаем:

$$\frac{q}{C} = \frac{q}{C_1} + \frac{q}{C_2} \implies \frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}.$$

